




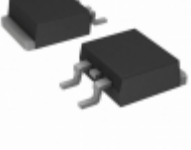


	<h2>IRFBE30PBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFBE30PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRFBE30PBF.pdf 2.IRFBE30PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4244 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFBE30PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4244 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4.1A (Tc) 125W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFBE30PBF

IRFBE30PBF ist neu im Original, Suche IRFBE30PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFBE30PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFBE30PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFBE30STRL Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p>IRFBE30LPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>	 <p>IRFBE30S Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p>IRFBE30S Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>
 <p>IRFBE30SPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p>IRFBE30LPBF-M IR IRFBE30LPBF-M IR</p>	 <p>IRFBE30SPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p>IRFBE30LPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>

heiße Teile

Mehr

IRFBC40F	IRFBC40LC	IRFBC40LC	IRFBC40LCPBF	IRFBC40LCPBF
IRFBC40LPBF	IRFBC40LPBF	IRFBC40S	IRFBC40S	IRFBC40SPBF
IRFBC40SPBF	IRFBC40STRL	IRFBC40STRL	IRFBC40STRLPBF	IRFBC40STRLPBF
IRFBC40STRR	IRFBC40STRR	IRFBC41LC	IRFBE20PBF	IRFBE20PBF
IRFBE20SPBF	IRFBE30L	IRFBE30L	IRFBE30LPBF-M	IRFBE30PBF
IRFBE30SPBF	IRFBE30SPBF	IRFBE30STRLPBF	IRFBE30STRLPBF	IRFBF20LPBF
IRFBF20LPBF	IRFBF20STRL	IRFBF20STRL	IRFBF20STRLPBF	IRFBF20STRLPBF
IRFBG20PBF	IRFBG20PBF	IRFBG30PBF	IRFBG30PBF	IRFBL10N60A
IRFC480LCD	IRFD010PBF	IRFD010PBF	IRFD020PBF	IRFD020PBF
IRFD110PBF	IRFD110PBF	IRFD120PBF	IRFD120PBF	IRFD12N06RLESM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

